

トランジスタ

T-33-13 2SC2415

2SC2415

シリコン NPN 三重拡散メサ形/Si NPN Triple Diffused Mesa

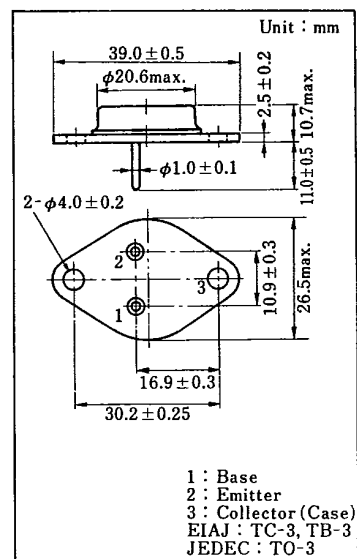
高速電力スイッチング用/High Speed Power Switching

■ 特徴/Features

- スイッチング速度が速い。/High speed switching
- ガラスパッシベーションによる高耐圧, 高信頼性。/
High voltage and high reliability realized by glass passivation

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	400	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	15	A
コレクタ電流	I_C	7	A
コレクタ損失(Tc=25 °C)	P_C	90	W
接合部温度	T_J	150	°C
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	°C

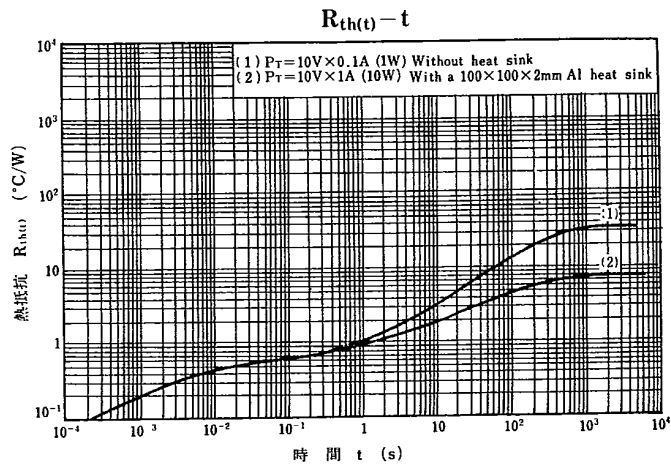
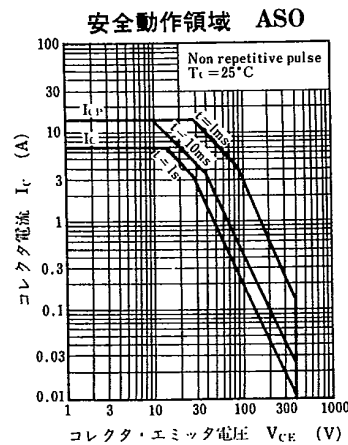
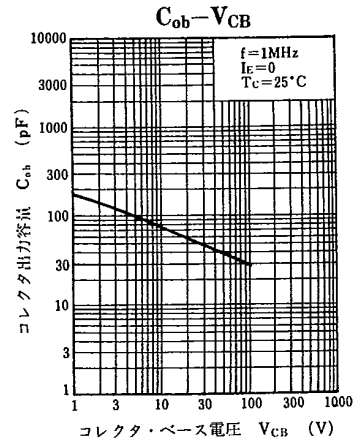
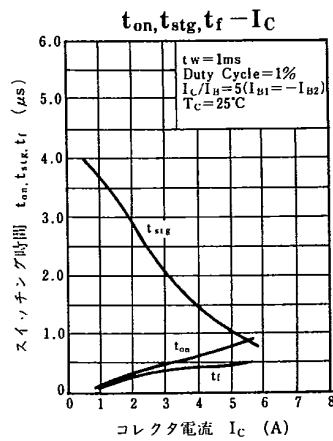
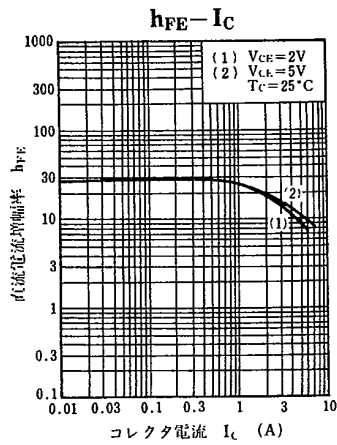
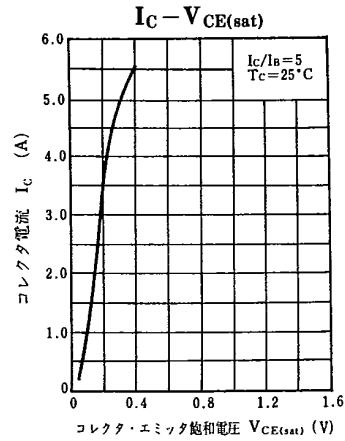
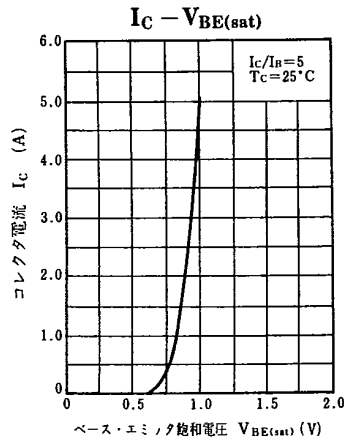
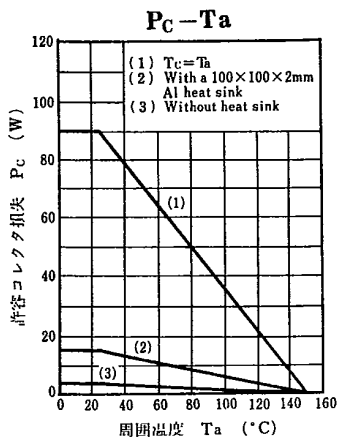


■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=500\text{ V}, I_E=0$			100	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{ V}, I_C=0$			100	μA
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE(sus)}$	$I_C=0.2\text{ A}, L=25\text{ mH}$	400			V
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=5\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	15			
	h_{FE2}	$V_{CE}=5\text{ V}, I_C=3\text{ A}$	8			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3\text{ A}, I_B=0.6\text{ A}$			1	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=3\text{ A}, I_B=0.6\text{ A}$			1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$		11		MHz
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=3\text{ A}, I_B=-I_{B2}=0.6\text{ A}$			1	μs
蓄積時間	t_{stg}				3	μs
下降時間	t_f				1	μs

トランジスタ

T-33-13 2SC2415



トランジスタ

2SC2480

2SC2480

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形/Si NPN Epitaxial Planar

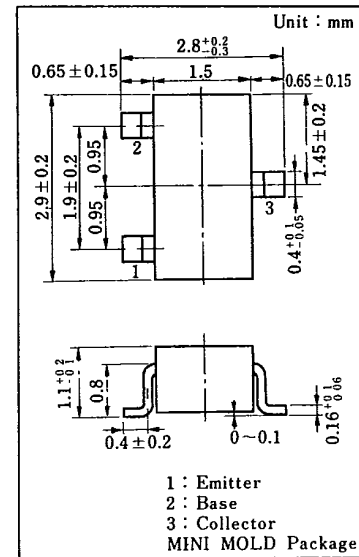
高周波増幅・発振・混合用/RF Amplifier, Oscillation, Mixer

■ 特徴/Feature

- トランジション周波数 f_T が高い。/High f_T

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	3	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	100	mW
接合部温度	T_J	125	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+125	°C



■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 100 \mu A, I_E = 0$	30			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10 \mu A, I_C = 0$	3			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 2 mA$	25			
トランジション周波数	f_T^*	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 15 mA$	600	1200	1600	MHz
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 2 mA$		0.72		V
掃選容量	C_{re}	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 1 mA$ $f = 10.7 MHz$		1		pF
電力利得	PG	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 1 mA, f = 100 MHz$		20		dB

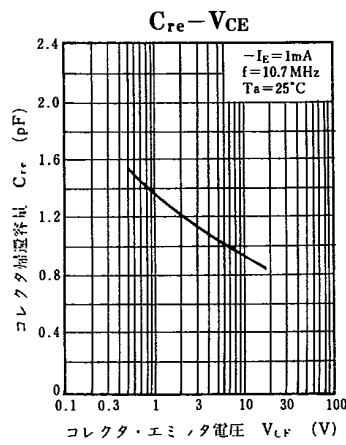
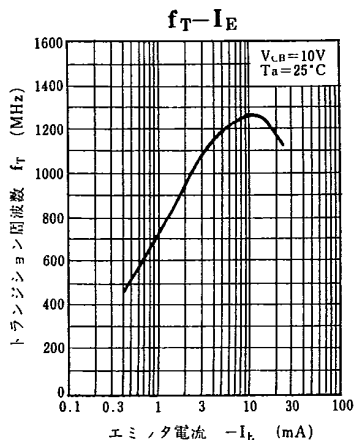
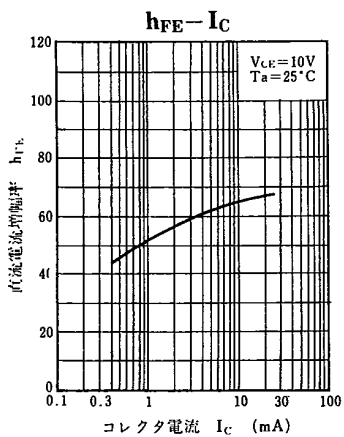
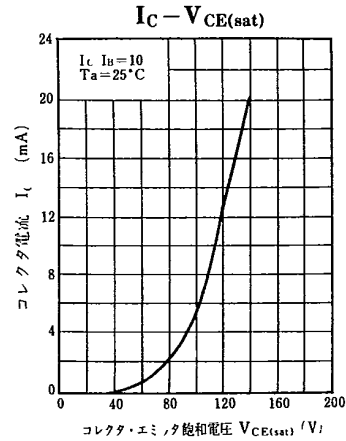
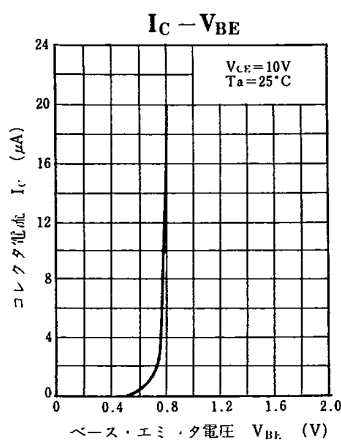
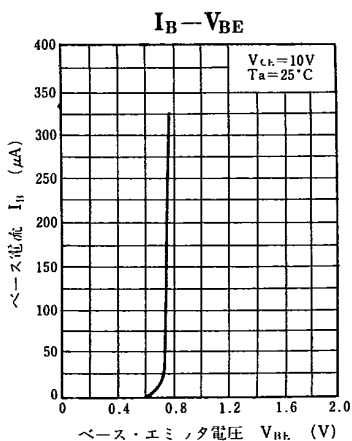
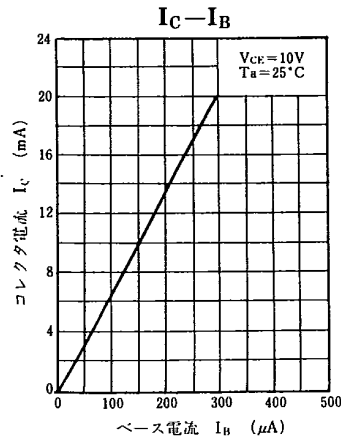
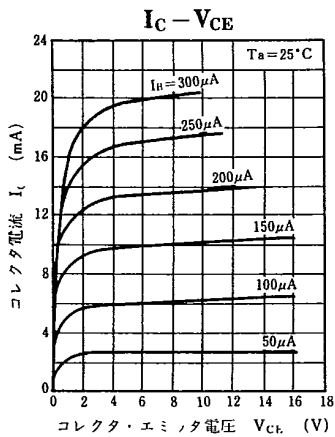
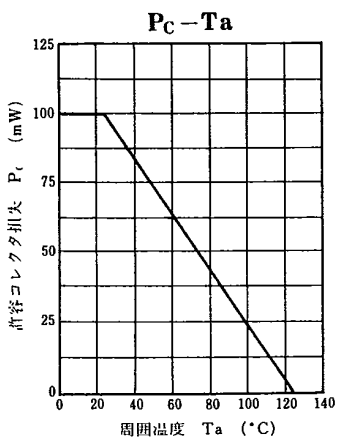
* f_T ランク分類 / f_T Classifications

Class	T	S
f_T (MHz)	600~1300	900~1600
Marking Symbol	RT	RS

トランジスタ

T-31-15

2SC2480



トランジスタ

T-31-15

2SC2480

